

**基本信息**

书名：信仰的力量(中国共产党人的初心)(精)

作者：编者:朱纪华

定价：380

出版社：学林

ISBN号：9787548613619

出版时间：2018-03-01

开本：12开

包装：精装

页数：266

**内容简介**

朱纪华主编的《信仰的力量(中国共产党人的初 心)(精)》一方面保留了展览的主体框架和展品精粹 ，包括中央档案馆珍藏的毛泽东、周恩来、刘少奇、 朱德、邓小平、陈云等老一辈无产阶级革命家的书信 和文稿等，以及上海市档案馆从德国、法国收集的《 共产党宣言》德文原稿、留法勤工俭学档案等，其中 不少是 公开披露，弥足珍贵；另一方面参考党史 学术研究成果，对说明文字进行了较大幅度的增补修 订，以使广大共产党员能够 好地重温“红色记忆” ，感受中国共产党人的理想之光、信念之光，从中汲 取永葆生机、不断前行的强大力量，从而使信仰追求 、责任担当、为民宗旨不断深植于广大党员的内心， 在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴 的征途中充分发挥先锋模范作用。

**目录**

序
导言
部分 追求真理
第二部分 坚定信念
第三部分 严守党纪
第四部分 勤政为民
第五部分 修身齐家
后记



**基本信息**

书名:物联网技术在智能配电网中的应用

定价：42.00元

作者:刘韶林

出版社：中国电力出版社

出版日期：2019-05-01

ISBN：9787519804947

页码：153

装帧：平装-胶订

开本：16开

**内容简介**

目前，物联网中的射频识别、无线传感器网络、全球定位技术等技术在电力系统生产、管理等各个环节都有所应用，协助实现有效的电网感知，提高了电力规范化管理能力。物联网在电力系统中的应用形成了电力物联网。电力物联网是在电力生产、输送、消费、管理各环节，广泛部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种智能感知设备，通过电力信息通信网络，可实现信息安全可靠传输、协同处理、统一服务及应用集成，从而实现电网运行及企业管理全过程的全景全息感知、互联互通及无缝整合。本书从河南鹤壁物联网应用示范工程出发，结合目前我国物联网应用\*技术和产品发展，介绍了物联网技术在智能配电网中的应用。本书共分六章，第一章介绍了物联网的基本概念，体系架构和相关传感器，第二章介绍了智能配电网的特征、主动配电网、配电自动化等相关知识。第三章介绍了电力物联网关键技术和工程应用情况，第四章介绍了\*发展的新型物联网传感器技术。第五章分在线监测、状态检修、全寿命周期管理、节能降损等四个方面介绍了面向配网运行与降损的物联网技术。第六章介绍了河南鹤壁物联网应用示范工程建设方案和工程建设成效。

**目　　录**

1 业扩现场风险防范措施
1.1 受理和资质审查
1.2 业扩现场勘察
1.3 供电方案拟订与执行
1.4 重要客户受电工程设计审查
1.5 重要客户中间检查
1.6 竣工检验
1.7 客户设备投运
2 分布式光伏并网现场风险防范措施
2.1 受理和资质审查
2.2 分布式光伏并网现场勘查
2.3 分布式光伏并网接入系统方案制订及答复
2.4 分布式光伏并网设计审查
2.5 分布式光伏并网验收与调试
3 电能计量现场风险防范措施
3.1 业扩现场勘查
3.2 工程竣工验收
3.3 计量装置装换
3.4 计量装置现场检验
3.5 计量装置故障处理
3.6 计量装置检定
3.7 计量装置仓储配送
3.8 计量装置运行
3.9 电能表装拆服务
3.10 客户申校
3.11 计量检定服务
4 用电检查现场风险防范措施
4.1 用电检查及反窃电
4.2 重要及高危客户管理
5 智能用电现场风险防范措施
5.1 用户充电服务安全
5.2 充电设施巡视安全
5.3 充电设施检修安全
5.4 施工机械、护具安全
5.5 充电设施土建工程
5.6 充电设施电气安装
6 抄表现场风险防范措施
附录 营销现场作业安全工作要求

![QPG]S}EH36NAXH{K(0KQ~(9]()

**基本信息**

书名:往后余生都是你

定价：39.80元

作者:大柠

出版社：百花洲文艺出版社

出版日期：2019-02-01

ISBN：9787550031692

装帧：平装-胶订

开本：32

页数：384

**内容简介**

“你知道最动听的一句情话吗？”他问。“我喜欢你？”

他摇头。“我想和你在一起？”他依然摇头。“我想和你住在一起？”他笑：“最动听的情话不是‘我想你’，也不是‘我想睡你’，而是‘我想睡醒后有你’。这就是我想象中的生活。”

七年前，在学校八百米的跑道上，他是她的领跑员，她咬牙切齿地追了他一圈又一圈。七年后，他说，我不想做你的路人，只想参与你的余生。现在，轮到我追你了。爱不会缺席，但可能会姗姗来迟，自从遇见你，余生都是你。

**目　　录**

第一章       原来你也在这里

第二章       我遇见谁会有怎样的对白

第三章       你是我的领跑员

第四章       能不能再靠近一点点

第五章       曾有一人点亮全世界

第六章       我的心是一个站牌

第七章       我只想亲你噘起的嘴

第八章       爱情是两颗心的碰撞

第九章       你是我蓄谋已久的重逢

第十章       只要最后是你就好

第十一章     恋爱就像升级打怪

第十二章     你的吻像海边温润的风

第十三章     如何想你想到六点

第十四章     你的双手四季如春

第十五章     南风未起，念你成疾

第十六章     你眼里有满天星光

第十七章     我想睡醒后有你

第十八章     深吻后握手言和

第十九章     云余共赴“巫山云雨”

第二十章     倘若有台时光机

第二十一章   恋爱后连空气都是甜的

第二十二章   一场别出心裁的求婚

第二十三章   乔木何许兮，山高水长

第二十四章   和你共享无尽的清晨

第二十五章   当一棵与你并肩而立的树

第二十六章   等疾风暴雨降临

第二十七章   吃了这碗闭门羹

第二十八章   一入乔家门，终身不复还

第二十九章   告别是为了更好地归来

第三十章     时差六小时的爱恋

第三十一章   我的心动地图

第三十二章   心不在一起才是异地恋

第三十三章   身边的传奇故事

第三十四章   漂洋过海的晚安吻

第三十五章   飞到思念的彼端

第三十六章   罗马假日甜如蜜

第三十七章   相见时难别亦难

第三十八章   许你无条件答应卡

第三十九章   一时欢喜，一生惦记

第四十章     你不完美的样子也很好

第四十一章   一加一，等于三

第四十二章   自从遇见你，余生都是你

后记　　　   有一种喜欢叫陪伴



**基本信息**

书名:图解芯片技术

定价：49.00元

作者:田民波

出版日期：2019-07

ISBN：9787122339607

页码：298

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

**内容简介**

针对入门者、应用者及研究开发者的多方面的需求，《图解芯片技术》在汇集大量资料的前提下，采用图文并茂的形式，全面且简明扼要地介绍芯片工作原理，集成电路材料，制作工艺，芯片的新进展、新应用及发展前景等。采用每章之下“节节清”的论述方式，左文右图，图文对照，并给出“本节重点”。力求做到深入浅出，通俗易懂；层次分明，思路清晰；内容丰富，重点突出；选材新颖，强调应用。 本书可供微电子、材料、物理、精密仪器等学科本科生及相关领域的工程技术人员参考。

**目 录**

第1章 集成电路简介
1.1 概述2
1.1.1 从分立元件到集成电路2
1.1.2 由硅圆片到芯片再到封装4
1.1.3 三极管的功能——可以比作通过水闸的水路6
1.1.4 n沟道MOS（nMOS）三极管的工作原理 8
1.1.5 截止状态下MOS器件中的泄漏电流10
1.2 半导体硅材料——集成电路的核心与基础12
1.2.1 MOS型与双极结型晶体管的比较12
1.2.2 CMOS构造的断面模式图（p型硅基板）14
1.2.3 快闪存储器单元三极管“写入”“擦除”“读取”的工作原理16
1.3 集成电路元件的分类18
1.3.1 IC的功能及类型18
1.3.2 RAM和ROM20
1.3.3 半导体器件的分类方法22
1.4 半导体器件的制作工艺流程24
1.4.1 前道工艺和后道工艺24
1.4.2 IC芯片制造工艺流程简介26
书角茶桌
集成电路发展史上的十大里程碑事件28

第2章 从硅石到晶圆
2.1 半导体硅材料36
2.1.1 硅是目前\*重要的半导体材料36
2.1.2 单晶硅中的晶体缺陷38
2.1.3 pn结中杂质的能级40
2.1.4 按电阻对绝缘体、半导体、导体的分类42
2.2 从硅石到金属硅，再到99.999999999%的高纯硅44
2.2.1 从晶石原料到半导体元器件的制程44
2.2.2 从硅石还原为金属硅46
2.2.3 多晶硅的析出和生长48
2.3 从多晶硅到单晶硅棒50
2.3.1 改良西门子法生产多晶硅 50
2.3.2 直拉法（Czochralski，CZ法）拉制单晶硅52
2.3.3 区熔法制作单晶硅54
2.3.4 直拉法中位错产生的原因及消除措施56
2.4 从单晶硅到晶圆58
2.4.1 晶圆尺寸不断扩大 58
2.4.2 先要进行取向标志的加工60
2.4.3 将硅坯切割成一片一片的硅圆片62
2.4.4 硅圆片有各种不同的类型64
2.5 抛光片、退火片、外延片、SOI片66
2.5.1 抛光片和退火片66
2.5.2 外延片68
2.5.3 SOI片70
书角茶桌
“硅是上帝赐予人类的宝物”72

第3章 集成电路制作工艺流程
3.1 集成电路逻辑LSI元件的结构74
3.1.1 双极结型器件的结构74
3.1.2 硅栅MOS器件的结构76
3.1.3 硅栅CMOS器件的结构78
3.1.4 BiCMOS器件和SOI器件的结构80
3.2 LSI的制作工艺流程82
3.2.1 利用光刻形成接触孔和布线层的实例82
3.2.2 曝光，显影84
3.2.3 光刻工程发展梗概86
3.2.4 “负型”和“正型”光刻胶感光反应原理88
3.2.5 光刻工艺流程90
3.2.6 硅圆片清洗、氧化、绝缘膜生长——光刻92
3.2.7 绝缘膜区域刻蚀——栅氧化膜的形成94
3.2.8 栅电极多晶硅生长——向n沟道源-漏的离子注入96
3.2.9 向p沟道的光刻、硼离子注入——欧姆接触埋置98
3.2.10 第1层金属膜生长——电极焊盘形成100
3.2.11 铜布线的大马士革工艺 102
3.2.12 如何发展我们的IC芯片制造产业104
3.3 IC芯片制造工艺的分类和组合106
3.3.1 IC芯片制造中的基本工艺 106
3.3.2 IC芯片制造中的复合工艺108
3.3.3 工艺过程的模块化110
3.3.4 基板工艺和布线工艺112
书角茶桌
世界集成电路产业发展的领军人物114

第4章 薄膜沉积和图形加工
4.1 DRAM元件和LSI元件中使用的各种薄膜120
4.1.1 元件结构及使用的各种薄膜120
4.1.2 DRAM中电容结构的变迁122
4.1.3 DRAM中的三维结构存储单元124
4.1.4 薄膜材料在集成电路中的应用126
4.2 IC制作用的薄膜及薄膜沉积（1）——PVD法128
4.2.1 VLSI制作中应用不同种类的薄膜128
4.2.2 多晶硅薄膜在集成电路中的应用130
4.2.3 IC制程中常用的金属132
4.2.4 真空蒸镀134
4.2.5 离子溅射和溅射镀膜136
4.3 IC制作用的薄膜及薄膜沉积（2）——CVD法138
4.3.1 用于VLSI制作的CVD法分类138
4.3.2 CVD中主要的反应装置140
4.3.3 等离子体CVD（PCVD）过程中传输、 反应和成膜的过程142
4.3.4 晶圆流程中的各种处理室方式144
4.4 IC制作用的薄膜及薄膜沉积（3）——各种方法的比较146
4.4.1 各种成膜方法的比较146
4.4.2 热氧化膜的形成方法148
4.4.3 热氧化膜的形成过程150
4.4.4 用于VLSI的薄膜种类和制作方法 152
4.4.5 用于VLSI制作的CVD法154
4.5 布线缺陷的改进和消除——Cu布线代替Al布线156
4.5.1 影响电子元器件寿命的大敌——电迁移156
4.5.2 断线和电路缺陷的形成原因以及预防、修补措施158
4.5.3 Cu布线代替Al布线的理由160
4.5.4 用电镀法即可制作Cu布线162
4.5.5 铝用于IC芯片的优缺点 164
4.6 曝光光源不断向短波长进展166
4.6.1 如何由薄膜加工成图形166
4.6.2 几种常用的光曝光方法168
4.6.3 光刻对周边技术的要求170
4.6.4 曝光波长的变迁及相关的技术保证172
4.6.5 光刻系统的发展及展望174
4.7 光学曝光技术176
4.7.1 图形曝光装置的分类及变迁176
4.7.2 光曝光方式178
4.7.3 近接曝光和缩小投影曝光180
4.7.4 曝光中的各种位相补偿措施182
4.8 电子束曝光和离子束曝光技术184
4.8.1 电子束曝光技术184
4.8.2 低能电子束近接曝光（LEEPL）技术186
4.8.3 软X射线缩小投影(EUV)曝光技术188
4.8.4 离子束曝光技术190
4.9 干法刻蚀替代湿法刻蚀192
4.9.1 刻蚀技术在VLSI制作中的应用192
4.9.2 干法刻蚀与湿法刻蚀的比较194
4.9.3 干法刻蚀装置的种类及刻蚀特征196
4.9.4 干法刻蚀（RIE模式）反应中所发生的现象198
4.9.5 高密度等离子体刻蚀装置200
书角茶桌
世界芯片产业的十大领头企业202

第5章 杂质掺杂——热扩散和离子注入
5.1 集成电路制造中的热处理工艺208
5.1.1 IC芯片制程中的热处理工艺（Hot Process）208
5.1.2 热氧化膜的形成技术210
5.1.3 至关重要的栅绝缘膜212
5.2 用于杂质掺杂的热扩散工艺214
5.2.1 LSI制作中杂质导入的目的214
5.2.2 杂质掺杂中离子注入法与热扩散法的比较216
5.2.3 求解热扩散杂质的浓度分布218
5.2.4 热处理的目的——推进，平坦化，电气活性化220
5.2.5 硅中杂质元素的行为222
5.3 精准的杂质掺杂技术（1）——离子注入的原理224
5.3.1 离子注入原理224
5.3.2 离子注入装置226
5.3.3 低能离子注入和高速退火228
5.3.4 离子注入的浓度分布230
5.4 精准的杂质掺杂技术（2）——离子注入的应用232
5.4.1 标准的MOS三极管中离子注入的部位232
5.4.2 基本的阱构造及倒梯度阱构造234
5.4.3 单阱形成236
5.4.4 双阱形成238
5.4.5 离子注入在CMOS中的应用240
5.4.6 离子注入用于浅结形成242
书角茶桌
“核心技术是国之重器”244

第6章 摩尔定律能否继续有效
6.1 多层化布线已进入第4代246
6.1.1 多层化布线——适应微细化和高集成度的要求246
6.1.2 第1代和第2代多层化布线技术——逐层沉积和玻璃流平248
6.1.3 第3代多层化布线技术——导入CMP250
6.1.4 第4代多层化布线技术——导入大马士革工艺252
6.2 铜布线的单大马士革和双大马士革工艺254
6.2.1 Cu大马士革布线逐渐代替Al布线254
6.2.2 大马士革工艺即#的景泰蓝金属镶嵌工艺256
6.2.3 从Al布线 W柱塞到Cu双大马士革布线258
6.2.4 Cu双大马士革布线结构及可能出现的问题260
6.3 摩尔定律能否继续有效？262
6.3.1 半导体器件向巨大化和微细化发展的两个趋势262
6.3.2 芯片集成度不断沿摩尔定律轨迹前进264
6.3.3 “摩尔定律并非物理学定律”,“而是描述产业化的定律” 266
6.3.4 “踮起脚来，跳起来摘苹果”268
6.4 新材料的导入——“制造材料者制造技术”270
6.4.1 多层布线层间膜，DRAM电容膜，Cu布线材料270
6.4.2 硅材料体系仍有潜力（1）272
6.4.3 硅材料体系仍有潜力（2）274
6.4.4 化合物半导体焕发活力276
6.5 如何实现器件的高性能？278
6.5.1 整机对器件的高性能化要求越来越高278
6.5.2 器件的高性能化依赖于新工艺、新材料280
6.5.3 要同时从基板工艺和布线工艺入手282
6.6 从100nm到7nm——以材料和工艺的创新为支撑284
6.6.1 纯硅基MOS管和多晶硅/high-k基MOS管284
6.6.2 金属栅/high-k基MOS管和鳍式场效应晶体管（FinFET）286
6.6.3 90nm——应变硅288
6.6.4 45nm——high-k绝缘层和金属栅极290
6.6.5 22nm——鳍式场效应晶体管292
6.6.6 7nm —— EUV 光刻和 SiGe-Channel294

参考文献297

作者简介298

![RE`]7BZTCEMMP2YHY812X_Q]()

**基本信息**

书名:时代的面影·当代文艺论集

定价：39.00元

作者:李松睿

出版社：上海文艺出版社

出版日期：2019-05-01

ISBN：9787532167449

装帧：平装-胶订

开本：32开

**内容简介**

文学研究究竟应该固守文学的“本分”，在自身学科的疆域内深耕细作，还是应该关注时代的重大问题，以跨学科的视野反思文学本身？《时代的面影》收录李松睿的十九篇文艺评论，涉及当代文学、影视剧以及美术领域等。虽然分析对象各不相同，但处理问题的方法都是通过考察文艺作品的形式特征，思考形式上携带的社会历史印痕。
 李松睿在这本书里回答了自己的疑问。真诚有力的文学研究，都生发自研究者的生命经验和现实困惑。批评工作并不一定只是所谓灵魂的冒险，它可以而且应该成为身处学院的知识分子面对世界、介入现实的一种独特方式。

**目 录**

序
第一辑  时代的症候
“紧紧抓住时代”——谈徐冰的艺术创作
时代的面影——谈20世纪90年代初的“大脸油画”
“自我批评与正义继承的道路”——新旧版《心灵史》对读
以“信仰”的名义——论电视剧《潜伏》
“小时代”的模范居民——读陈栢青的《小城市》
沪上传奇与异邦故事——谈朱晓琳近年来的小说创作
第二辑  书写的困境
“生命政治”与历史书写的困境——论莫言的长篇小说《蛙》
思想出场的空间与可能——读刘继明的长篇小说《人境》
多余的人如何归来——论电影《秋之白华》
后革命时代的艺术与爱情——谈新编黄梅戏版《雷雨》
弱者的姿态——评电影《我的名字叫可汗》
第三辑  危机时刻的想象
社会转型与“灵氛”的消逝——以《大宅门》系列电视剧为中心
多重镜像中的叙事——谈2013年版《了不起的盖茨比》
《盗梦空间》：归家故事与光环的消逝
帝国斜阳——托马斯•阿尔弗雷德森的电影世界
第四辑  域外镜鉴
黑洞、暴力与无悔的青春
星辰陨落，何日再现？
为什么生活在一起是如此艰难？——读马琳娜•柳薇卡
杀戮面前，要真相还是遗忘？
后记